

BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1749 der Kommission vom 7. Oktober 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

(Amtsblatt der Europäischen Union L 421 vom 14. Dezember 2020)

1. Seite 94, Nummer 2B206c1 und 2B206c2 erhalten folgende Fassung:
 - „1. sie enthalten einen ‚Laser‘ und
 2. sie behalten über mindestens 12 Stunden bei einer Temperatur von ± 1 K (± 1 °C) bei Standardtemperatur und Standarddruck alle folgenden Eigenschaften bei:
 - a) ‚Auflösung‘ von 0,1 μm oder kleiner (besser) über den vollen Messbereich und
 - b) eine ‚Messunsicherheit‘ kleiner(besser)/gleich $(0,2 + L/2\ 000)$ μm (Messlänge L in mm).“
2. Seite 142, Nummer 3B001f3 und 3B001g erhalten folgende Fassung:
 - „3. Anlagen, besonders konstruiert für die Maskenherstellung mit allen folgenden Eigenschaften:
 - a) abgelenkten, fokussierten Elektronenstrahlen, Ionenstrahlen oder ‚Laser‘-Strahlen und
 - b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
 1. Fokusgröße (spot size) mit einer Halbwertsbreite (full-width half-maximum (FWHM)) kleiner als 65 nm und einer Justiergenauigkeit (image placement) kleiner als 17 nm (Mittelwert + 3 Sigma) oder
 2. nicht belegt;
 3. Überdeckungsfehler (overlay error) der zweiten Schicht auf der Maske kleiner als 23 nm (Mittelwert + 3 Sigma),
 4. Anlagen für die Halbleiterherstellung, die Direktschreibverfahren verwenden, mit allen folgenden Eigenschaften:
 - a) abgelenkten, fokussierten Elektronenstrahlen und
 - b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
 1. Mindeststrahlgröße (Minimum beam size) kleiner/gleich 15 nm oder
 2. Überdeckungsfehler (overlay error) kleiner als 27 nm (Mittelwert + 3 Sigma),
 - g) Masken oder Reticles, entwickelt für von Nummer 3A001 erfasste integrierte Schaltungen;“.
3. S. 160, Nummern 5E001d bis 5E001e2 erhalten folgende Fassung:
 - d) ‚Technologie‘ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für die ‚Entwicklung‘ oder ‚Herstellung‘ von ‚monolithisch integrierten Mikrowellenverstärkerschaltungen‘ (MMIC-Verstärker), besonders entwickelt für die Telekommunikation, mit einer der folgenden Eigenschaften:

Technische Anmerkung:

Im Sinne der Unternummer 5E001d kann der Parameter Spitzensättigungsausgangsleistung auf Produktdatenblättern auch als Ausgangsleistung, Sättigungsausgangsleistung, Höchstaussgangsleistung, Spitzenausgangsleistung oder Hüllkurvenspitzenleistung bezeichnet werden.

 1. ausgelegt für den Betrieb bei Frequenzen größer als 2,7 GHz bis einschließlich 6,8 GHz, bei einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 15 % und mit einer der folgenden Eigenschaften:
 - a) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 75 W (48,75 dBm) bei einer Frequenz größer als 2,7 GHz bis einschließlich 2,9 GHz,
 - b) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 55 W (47,4 dBm) bei einer Frequenz größer als 2,9 GHz bis einschließlich 3,2 GHz,
 - c) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 40 W (46 dBm) bei einer Frequenz größer als 3,2 GHz bis einschließlich 3,7 GHz oder
 - d) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 20 W (43 dBm) bei einer Frequenz größer als 3,7 GHz bis einschließlich 6,8 GHz;

2. ausgelegt für den Betrieb bei Frequenzen größer als 6,8 GHz bis einschließlich 16 GHz, bei einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 10 % und mit einer der folgenden Eigenschaften:
 - a) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 10 W (40 dBm) bei einer Frequenz größer als 6,8 GHz bis einschließlich 8,5 GHz oder
 - b) Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 5 W (37 dBm) bei einer Frequenz größer als 8,5 GHz bis einschließlich 16 GHz;
 3. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 3 W (34,77 dBm) bei einer Frequenz größer als 16 GHz bis einschließlich 31,8 GHz und einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 10 %;
 4. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 0,1 nW (– 70 dBm) bei einer Frequenz größer als 31,8 GHz bis einschließlich 37 GHz;
 5. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 1 W (30 dBm) bei einer Frequenz größer als 37 GHz bis einschließlich 43,5 GHz und einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 10 %;
 6. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 31,62 mW (15 dBm) bei einer Frequenz größer als 43,5 GHz bis einschließlich 75 GHz und einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 10 %;
 7. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 10 mW (10 dBm) bei einer Frequenz größer als 75 GHz bis einschließlich 90 GHz und einer ‚normierten Bandbreite‘ (fractional bandwidth) größer als 5 % oder
 8. ausgelegt für den Betrieb mit einer Spitzensättigungsausgangsleistung größer als 0,1 nW (– 70 dBm) bei einer Frequenz größer als 90 GHz;
- e) ‚Technologie‘ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für die ‚Entwicklung‘ oder ‚Herstellung‘ elektronischer Bauelemente oder Schaltungen, die Bauteile aus ‚supraleitenden‘ Werkstoffen oder Materialien enthalten, besonders entwickelt für die Telekommunikation, besonders konstruiert für den Betrieb bei Temperaturen unter der ‚kritischen Temperatur‘ von wenigstens einem ihrer ‚supraleitenden‘ Bestandteile und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Stromschalter für digitale Schaltungen mit ‚supraleitenden‘ Gattern mit einem Produkt aus Laufzeit pro Gatter (in Sekunden) und Verlustleistung je Gatter (in Watt) kleiner als 10^{-14} J oder
 2. Frequenzselektion bei allen Frequenzen mit Resonanzkreisen, die Gütefaktoren von mehr als 10 000 aufweisen.‘
4. Seite 175, Nummern 6A002a1a bis 6A002a1d erhalten folgende Fassung:
- „1. ‚weltraumgeeignete‘ Halbleiterdetektoren wie folgt:
- Anmerkung: Für die Zwecke der Unternummer 6A002a1 umfassen Halbleiterdetektoren auch ‚Focal-plane-arrays‘.*
- a) ‚weltraumgeeignete‘ Halbleiterdetektoren mit allen folgenden Eigenschaften:
 1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlängenbereichs größer als 10 nm und kleiner/gleich 300 nm und
 2. Empfindlichkeit kleiner als 0,1 % bezogen auf die Spitzenempfindlichkeit bei einer Wellenlänge größer als 400 nm,
 - b) ‚weltraumgeeignete‘ Halbleiterdetektoren mit allen folgenden Eigenschaften:
 1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlängenbereichs größer als 900 nm und kleiner/gleich 1 200 nm und
 2. Ansprechzeitkonstante‘ kleiner/gleich 95 ns,
 - c) ‚weltraumgeeignete‘ Halbleiterdetektoren mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlängenbereichs von größer als 1 200 nm und kleiner/gleich 30 000 nm,
 - d) ‚weltraumgeeignete‘ ‚Focal-plane-arrays‘ mit mehr als 2 048 Elementen pro Array und einer Spitzenempfindlichkeit im Wellenlängenbereich größer als 300 nm und kleiner/gleich 900 nm,“.
-